

考试和答疑

- 考试安排

- * 时间：6月28日上午8:30~10:30

- * 地点：HGX307+308

- 考前答疑

- * 时间：6月26日上午9:30~11:30

- * 地点：光华楼东主楼2422+2417

上讲回顾：输运问题的半经典处理

- Bloch电子 ← 准经典处理

- * 电流密度 → 电子速度 * 电子分布函数

- * 分布函数的变化 → 满足 Boltzmann 方程

- 碰撞和漂移分开考虑！

- * 即使无外场也有碰撞

- * 漂移项在 Bloch 电子近似下由能带结构定，容易处理

- * 碰撞项用弛豫时间近似

$$\dot{\mathbf{r}} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}} + \dot{\mathbf{k}} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{k}} = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{碰撞}}$$

- τ 与散射矩阵有关

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{(2\pi)^3} \int \Theta_{\mathbf{k}',\mathbf{k}} [1 - \cos \vartheta] d\mathbf{k}'$$

- * 微扰方法处理电子-声子作用 → 散射矩阵

- 金属电导率

$$\sigma = \frac{ne^2\tau(E_F)}{m^*}$$

本讲目的：其他输运现象？

- Boltzmann方程在热传导、热电势等问题上的应用

第30讲、其他输运现象

1. 杂质电阻
2. 热导率
3. 热电势
4. Hall系数和磁阻

1、杂质电阻(剩余电阻)

- 声子散射产生的电阻，纯净金属电阻，亦称为理想电阻
- 低温时，晶格散射可以忽略，仍有电阻，来源于杂质散射→杂质使周期性势场被破坏。微扰 U 使散射矩阵

$$\Theta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} = \frac{2\pi}{\hbar} n \left| \langle \psi_{\mathbf{k}'} | U(\mathbf{r}) | \psi_{\mathbf{k}} \rangle \right|^2 \delta(E(\mathbf{k}') - E(\mathbf{k}))$$

- 杂质浓度 n 、散射势场 $U(\mathbf{r})$ 与温度无关，因此产生的电阻与温度无关
- 假定电子被声子和杂质散射机制互相无关，则总散射几率为两者之和

$$\Theta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} = \Theta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}^{\text{声子}} + \Theta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}^{\text{杂质}}$$

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau^{\text{声子}}} + \frac{1}{\tau^{\text{杂质}}}$$

$$\rho = \rho^{\text{声子}} + \rho^{\text{杂质}}$$

杂质势→弛豫时间

- 电离杂质附近的电子势能可表示成

$$U(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r} e^{-\lambda r}$$

* Z =有效电荷, 指数因子是电荷屏蔽作用

- 由量子力学波恩近似方法, 可得散射微分截面

$$\sigma(\vartheta) = \left(\frac{2m^* Ze^2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 \hbar^2} \right) \frac{1}{(K^2 + \lambda^2)^2}$$

$$K = |\mathbf{k}' - \mathbf{k}| = 2k_F \sin \frac{\vartheta}{2}$$

* θ 是散射角

- 以 v 速度入射至电离杂质, 在单位时间内被散射的电子数

$$\frac{N}{V} v \sigma(\vartheta) d\Omega$$

- 比较散射矩阵元后可得

$$\Theta(k, k', \vartheta) = \frac{v \sigma(\vartheta)}{V}$$

- 如果有 N_I 个杂质离子，各个又互相独立则

$$\Theta(k, k', \mathcal{G}) = \frac{N_I}{V} v \sigma(\mathcal{G}) = n_I v \sigma(\mathcal{G})$$

- 由杂质散射导致的弛豫时间为

$$\frac{1}{\tau_I} = n_I v_F \int \sigma(\theta) (1 - \cos \theta) 2\pi \sin \theta d\theta$$

$$= 2\pi n_I v_F \left(\frac{2m^* Z e^2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 \hbar^2} \right)^2 \int \frac{(1 - \cos \theta) \sin \theta d\theta}{(K^2 + \lambda^2)^2}$$

$$\text{令 } x = \sin \frac{\theta}{2}$$

$$= 2\pi n_I v_F \left(\frac{2m^* Z e^2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 \hbar^2 \lambda^2} \right)^2 \int_0^1 \frac{8x^3 dx}{\left(1 + (2k_F / \lambda)^2 x^2\right)}$$

- 剩余电阻与温度无关

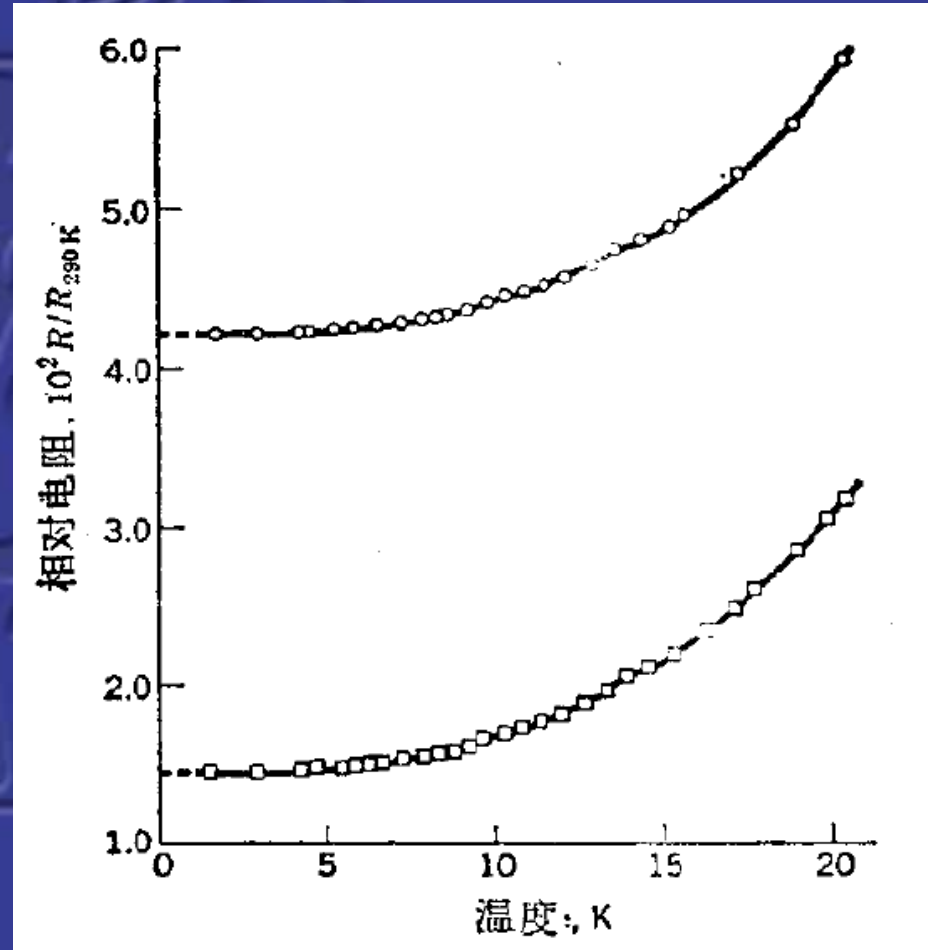
缺陷浓度不同样品电阻实验结果

- 这是钾的两个样品在20K以下的电阻随温度的变化

- * 不同样品有不同的缺陷浓度，故其电阻向零K外延显示了不同的截距
- * 这就是剩余电阻与缺陷的关系，与温度无关

$$\rho = \rho_{\text{原子振动}} + \rho_{\text{缺陷}}$$

- * 温度低到一定值后，主要是剩余电阻的贡献



2、热导率(金属电子贡献)

- 金属中电子对导热的贡献
 - * 实际上是电子与声子的共同贡献
 - * 金属中电子浓度高得多，因此，电子对导热的贡献一般比声子高两个量级，故金属导热一般指电子
- 自由电子气模型电子对导热的贡献？
 - * 由理想气体、费米速度和比热与温度关系即可得
- 导热过程中声子有两种作用
 1. 维持温度梯度；
 2. 建立热电场使电流为零
- 用Boltzman方程来讨论电子导热问题

$$\dot{\mathbf{r}} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}} + \dot{\mathbf{k}} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{k}} = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{碰撞}}$$

- 有温度梯度时，分布函数的导数通过 \mathbf{r} 与温度 T 发生联系，对分布函数求导

$$\dot{\mathbf{r}} \cdot \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{r}} = \dot{\mathbf{r}} \cdot \frac{\partial T}{\partial \mathbf{r}} \frac{\partial f_0}{\partial T} + \dot{\mathbf{r}} \cdot \frac{\partial f_0}{\partial E_F} \frac{\partial E_F}{\partial \mathbf{r}}$$

$$\frac{\partial f_0}{\partial T} = - \frac{E - E_F}{T} \frac{\partial f_0}{\partial E}$$

$$\frac{\partial f_0}{\partial E_F} = - \frac{\partial f_0}{\partial E}$$

- 即可得

$$\dot{\mathbf{r}} \cdot \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{r}} = - \frac{\partial f_0}{\partial E} \dot{\mathbf{r}} \cdot \left(\frac{E - E_F}{T} \frac{\partial T}{\partial \mathbf{r}} + \frac{\partial E_F}{\partial \mathbf{r}} \right)$$

- 电子导热将伴随着带电粒子的移动，将建立起内电场，所以仍需保留电场影响，即

$$- \frac{\partial f_0}{\partial E} \mathbf{v} \cdot \left(\frac{E - E_F}{T} \frac{\partial T}{\partial \mathbf{r}} + \frac{\partial E_F}{\partial \mathbf{r}} \right) - \frac{e\mathcal{E}}{\hbar} \cdot \hbar \mathbf{v} \frac{\partial f_0}{\partial E} = - \frac{f - f_0}{\tau}$$

$$f = f_0 + \frac{\partial f_0}{\partial E} \tau \mathbf{v} \cdot \left(e\mathcal{E} + \frac{E - E_F}{T} \frac{\partial T}{\partial \mathbf{r}} + \frac{\partial E_F}{\partial \mathbf{r}} \right)$$

- 利用在电场和温度梯度同时存在时分布函数的一级近似，按电流和热流的定义分别得到电流

$$\mathbf{J} = -\frac{1}{4\pi^3} \int e f \mathbf{v} d\mathbf{k} = -\frac{e}{4\pi^3} \int \tau \mathbf{v} \mathbf{v} \cdot \left(e\mathcal{E} + \frac{E - E_F}{T} \frac{\partial T}{\partial \mathbf{r}} + \frac{\partial E_F}{\partial \mathbf{r}} \right) \frac{\partial f_0}{\partial E} d\mathbf{k}$$

和热流

$$\mathbf{J}_Q = \frac{1}{4\pi^3} \int (E - E_F) f \mathbf{v} d\mathbf{k} = \frac{1}{4\pi^3} \int (E - E_F) \tau \mathbf{v} \mathbf{v} \cdot \left(e\mathcal{E} + \frac{E - E_F}{T} \frac{\partial T}{\partial \mathbf{r}} + \frac{\partial E_F}{\partial \mathbf{r}} \right) \frac{\partial f_0}{\partial E} d\mathbf{k}$$

- 这里， $E - E_F$ 作为被传递的热量
 - * 这两个积分比较复杂，但形式上可以按 $(E - E_F)$ 不同幂，引入输运系数

- 先定义输运系数

$$\mathcal{L}_n = \frac{-1}{4\pi^3} \int \tau \mathbf{v} \mathbf{v} \cdot \frac{\partial f_0}{\partial E} (E - E_F)^n d\mathbf{k}$$

后，可以比较简洁地写出电流和热流

$$\mathbf{J} = e^2 \mathcal{L}_0 \cdot \left(\boldsymbol{\mathcal{E}} + \frac{1}{e} \frac{\partial E_F}{\partial \mathbf{r}} \right) + \frac{e}{T} \mathcal{L}_1 \frac{\partial T}{\partial \mathbf{r}}$$

$$\mathbf{J}_Q = -e \mathcal{L}_1 \cdot \left(\boldsymbol{\mathcal{E}} + \frac{1}{e} \frac{\partial E_F}{\partial \mathbf{r}} \right) - \frac{1}{T} \mathcal{L}_2 \frac{\partial T}{\partial \mathbf{r}}$$

- 化学势的梯度是通过温度建立的内电场，因此与电场并列在一起
- \mathcal{L} 是张量，简单起见，只考虑各向同性的情况

- 现在求 \mathcal{L} ，假定各向同性，只有对角元，则

$$\mathcal{L}_n = \frac{-1}{12\pi^3} \int \tau v_x^2 \frac{\partial f_0}{\partial E} (E - E_F)^n d\mathbf{k}_\perp ds = \frac{-1}{12\pi^3} \int \tau v_x^2 \frac{\partial f_0}{\partial E} (E - E_F)^n \frac{dE}{|\nabla_{\mathbf{k}} E|} ds$$

- 利用费米分布函数的性质，用Sommerfeld积分

$$\int Q(E) \left(-\frac{\partial f_0}{\partial E} \right) dE \approx Q(E_F) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 \left(\frac{\partial^2 Q}{\partial E^2} \right) \Big|_{E=E_F}$$

- 得到

$$\mathcal{L}_0 \approx \frac{1}{12\pi^3} \int \tau v_x^2 \frac{ds_F}{|\nabla_{\mathbf{k}} E|_{E_F}} = \frac{\tau}{12\pi^3 \hbar} \int v_x ds_F$$

$$\mathcal{L}_1 \approx \frac{1}{3} \pi^2 (k_B T)^2 \frac{\partial \mathcal{L}_0}{\partial E}$$

$$\mathcal{L}_2 \approx \frac{1}{3} \pi^2 (k_B T)^2 \mathcal{L}_0$$

- 对电流热流的 \mathcal{L} 联立方程

$$J = e^2 \mathcal{L}_0 \left(\mathcal{E}_x + \frac{\partial E_F}{\partial x} \right) + \frac{e}{T} \mathcal{L}_1 \frac{\partial T}{\partial x}$$

$$J_Q = -e \mathcal{L}_1 \left(\mathcal{E}_x + \frac{\partial E_F}{\partial x} \right) - \frac{1}{T} \mathcal{L}_2 \frac{\partial T}{\partial x}$$

\mathcal{L}_0 的求解仍困难。仍然利用自由电子气的结果

- 对等温、等化学势，对电流，有

$$J = e^2 \mathcal{L}_0 \mathcal{E}_x$$

- 比较欧姆定律

$$J = \sigma \mathcal{E}_x$$

- 即可得

$$\sigma = e^2 \mathcal{L}_0$$

- 金属热导率主要是电子贡献，而晶格热导则是次要的。按热导系数 χ 写出能量流，

$$J_Q = -\left(\chi \frac{\partial T}{\partial x}\right)_{J=0}$$

- 开路时，在电流热流的 \mathcal{L} 联立方程中， $J=0$ ，以此分离出电场+化学势求导项，就有


$$\left(\mathcal{E}_x + \frac{\partial E_F}{\partial x}\right) = -\frac{1}{eT} \frac{\mathcal{L}_1}{\mathcal{L}_0} \frac{\partial T}{\partial x}$$

- 代入后式得

$$J_Q = \frac{1}{T} \left(\frac{\mathcal{L}_1^2}{\mathcal{L}_0} - \mathcal{L}_2 \right) \frac{\partial T}{\partial x}$$

- 比较后得到传导电子对热传导系数的贡献(输运系数 \mathcal{L} 有关)

$$\chi = \frac{1}{T} \left(\mathcal{L}_2 - \frac{\mathcal{L}_1^2}{\mathcal{L}_0} \right)$$

The background features a large, faint watermark of the Fudan University Surface Science Lab logo. The logo is circular and contains the Chinese characters '表面物理' (Surface Physics) at the top, 'FUDAN UNIVERSITY' on the right, 'SURFACE LAB.' on the left, and 'FUDAN' at the bottom. In the center of the logo is a stylized Chinese character '理' (Li).

思考题：为什么在开路情况下，传导电子能传输热流？

Wiederman-Franz定律

- 热导系数如果略去后一项，得

$$\chi \approx \frac{\mathcal{L}_2}{T} = \frac{1}{3T} \pi^2 (k_B T)^2 \mathcal{L}_0 = \frac{1}{3} \left(\frac{\pi k_B}{e} \right)^2 \sigma T$$

- 即Lorenz数为 $L = \frac{\chi}{\sigma T} = \frac{1}{3} \left(\frac{\pi k_B}{e} \right)^2$

- 于是可得 $\chi = \sigma T \left(L - \frac{\mathcal{L}_1^2}{\sigma T^2 \mathcal{L}_0} \right)$

- 因此后一项可认为是对Lorenz数的修正

* 这是弹性散射的结果，要求能量的改变远小于 $k_B T$ ，即低温，电子主要受杂质散射

- 在高温时，主要受声子散射，电导率反比 T ，所以热导率基本与温度无关

3、热电势（Seebeck效应）

- 在电子导热过程中，电子—声子散射作用要复杂得多，不但要维持温度梯度，还要建立电场使电流为零——热电现象
- 电场下，电子加速，受声子散射形成稳定电流，测量电流有两种条件
 - * 等温条件：整个导体处于热平衡中
 - * 绝热条件：理想情况将出现
 - # 沿电流方向出现温度梯度
 - # 电流进口一端致冷，而出口升温
- 电子在电场和温度场同时存在下运动的结果

Seebeck效应

$$\mathbf{J} = e^2 \mathcal{L}_0 \cdot \left(\boldsymbol{\varepsilon} + \frac{1}{e} \frac{\partial E_F}{\partial \mathbf{r}} \right) + \frac{e}{T} \mathcal{L}_1 \frac{\partial T}{\partial \mathbf{r}}$$

- 1822年Seebeck发现将不同导体1和2两端结合成环（热偶），接头处保持不同温度 T' 和 T'' ，那么环路中将有电流通过，即存在电动势

——温差电动势

- 前面的温度梯度引起的电场可以解释这个现象

$$\boldsymbol{\varepsilon}_x = S \frac{\partial T}{\partial x}$$

- 令上面电流为零，并假定化学势处处相等，则可得热电动势 S

$$S = -\frac{1}{eT} \frac{\mathcal{L}_1}{\mathcal{L}_0}$$

- 由前面 $\mathcal{L}_1 \approx \frac{1}{3} \pi^2 (k_B T)^2 \frac{\partial \mathcal{L}_0}{\partial E}$ 和 $\sigma = e^2 \mathcal{L}_0$

- 得
$$S = - \frac{1}{eT} \frac{\mathcal{L}_1}{\mathcal{L}_0} = - \frac{\pi^2 k_B^2 T}{3e} \frac{\partial \ln \sigma}{\partial E} \Big|_{E=E_F}$$

- 该式形式简单，实际复杂，电导率是对费米面积分，在等能面为球面，而弛豫时间又是各向同性情况下，利用

$$\sigma = \frac{ne^2 \tau(E_F)}{m^*}$$

- 和

$$n(E) = \int_{-\infty}^{E_F} N(E) dE$$

- 得热电动势

$$S = \frac{\pi^2 k_B^2 T}{3e} \left(\frac{N(E)}{n} + \frac{1}{\tau} \frac{\partial \tau}{\partial E} \right)_{E_F}$$

- 利用自由电子气体的态密度,

$$N(E_F) = \frac{3}{2nE_F}$$

- 略去对弛豫时间的导数, 得

$$S = \frac{\pi^2}{3} \frac{3}{2} k_B \frac{k_B T}{E_F} \frac{1}{e} = c_{ve}$$

- 这正是电子对比热的贡献
 - * 电子由低温跨越单位梯度进入高温时所吸收的热量

The background features a large, faint, circular logo of the Surface Physics Lab at Fudan University. The logo contains the Chinese characters '表面物理' (Surface Physics) at the top, '復旦' (Fudan) in the center, and 'SURFACE LAB. FUDAN UNIV.' around the bottom edge.

思考题：能不能用自由电子气体模型定性说明热电现象？

4、Hall系数和磁阻

$$\dot{\mathbf{r}} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}} + \dot{\mathbf{k}} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{k}} = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{碰撞}}$$

- 稳定时， Boltzmann方程的第一项为零。对电子状态改变

$$-\frac{e}{\hbar} (\boldsymbol{\mathcal{E}} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{k}} = -\frac{f - f_0}{\tau}$$

- 假定线性响应，

$$\frac{e}{\hbar} \boldsymbol{\mathcal{E}} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{k}} = \frac{e}{\hbar} \boldsymbol{\mathcal{E}} \cdot \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{k}}$$

- 对 f_0 ，有

$$(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{k}} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} \frac{\partial f_0}{\partial E} = 0$$

- 所以

$$-\frac{e}{\hbar} \boldsymbol{\mathcal{E}} \cdot \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{k}} = -\frac{f_1}{\tau} + \frac{e}{\hbar} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \frac{\partial f_1}{\partial \mathbf{k}}$$

- 或仅考虑电场

$$f_1 = \frac{e\tau}{\hbar} \boldsymbol{\mathcal{E}} \cdot \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{k}} = e\tau \boldsymbol{\mathcal{E}} \cdot \mathbf{v} \frac{\partial f_0}{\partial E}$$

- 假定同时考虑电、磁场时解的形式类似(\mathbf{D} 待定)

$$f_1 = e\tau \mathbf{v} \cdot \mathbf{D} \frac{\partial f_0}{\partial E}$$

- 代入后得

$$\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\mathcal{E}} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{D} - \frac{e\tau}{m^*} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{D}$$

- 矢量运算后

$$\boldsymbol{\mathcal{E}} = \mathbf{D} - \frac{e\tau}{m^*} \mathbf{B} \times \mathbf{D}$$

- 稳态电流密度

$$\mathbf{J} = -\frac{e}{4\pi^3} \int f_1 \mathbf{v} d\mathbf{k} = \frac{e^2}{4\pi^3} \int \tau \mathbf{v} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{D}) \left(-\frac{\partial f_0}{\partial E} \right) \frac{ds_F}{\hbar v} dE$$

- 利用 $\mathbf{J} = \sigma_0 \mathbf{D}$ 和 $\rho_0 = 1/\sigma_0$, 前式成

$$\boldsymbol{\mathcal{E}} = \rho_0 \mathbf{J} - \frac{e\tau}{m^*} \rho_0 \mathbf{B} \times \mathbf{J}$$

- 对

$$\boldsymbol{\mathcal{E}} = \rho_0 \mathbf{J} - \frac{e\tau}{m^*} \rho_0 \mathbf{B} \times \mathbf{J}$$

- 沿电流方向

$$\mathcal{E}_{\parallel} = \rho_0 \mathbf{J}$$

- 磁场不改变样品电阻，**磁电阻为零**，与实验不符

- 如B与J垂直，横向Hall场为

$$\mathcal{E}_{\text{H}} = -\frac{e\tau}{m^*} \rho_0 B J$$

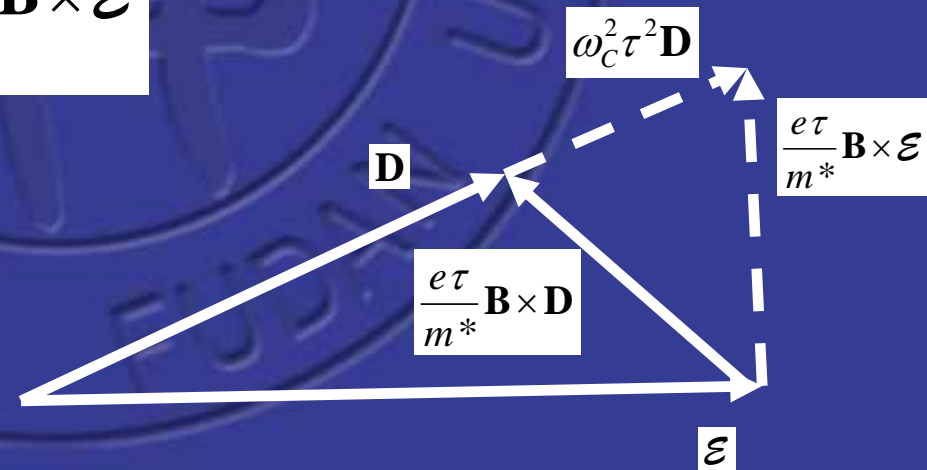
- Hall系数为

$$R_{\text{H}} = -\frac{e\tau}{m^*} \rho_0 = -\frac{1}{ne}$$

磁电阻效应

- 磁电阻为零于实验不符，原因是把所有电子假定同样速度、有效质量、弛豫时间。实际情况并不如此。现看由此引起的效应
- 由 $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{D} - \frac{e\tau}{m^*} \mathbf{B} \times \mathbf{D}$ 可得解为(可以将 \mathbf{D} 代入验证)

$$\mathbf{D} = \frac{1}{1 + \omega_c^2 \tau^2} \boldsymbol{\varepsilon} + \frac{e\tau/m^*}{1 + \omega_c^2 \tau^2} \mathbf{B} \times \boldsymbol{\varepsilon}$$



双能带模型→磁电阻效应

- 假定两种载流子在不同能带中，有不同有效质量，总电流为两种载流子电流和

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_1 + \mathbf{J}_2 = \sigma_{10} \mathbf{D} + \sigma_{20} \mathbf{D}$$

- $\mathbf{B} = Bz$

$$J_x = \left(\frac{\sigma_{10}}{1 + \omega_{c1}^2 \tau_1^2} + \frac{\sigma_{20}}{1 + \omega_{c2}^2 \tau_2^2} \right) E_x - \left(\frac{\sigma_{10} \omega_{c1} \tau_1}{1 + \omega_{c1}^2 \tau_1^2} + \frac{\sigma_{20} \omega_{c2} \tau_2}{1 + \omega_{c2}^2 \tau_2^2} \right) E_y$$

- $\mathbf{0} \rightarrow$

$$\mathbf{J} = \left(\frac{\sigma_{10}}{1 + \omega_c^2 \tau_1^2} + \frac{\sigma_{20}}{1 + \omega_c^2 \tau_2^2} \right) \boldsymbol{\varepsilon} + \left(\frac{\sigma_{10} e \tau_1 / m_1^*}{1 + \omega_c^2 \tau_1^2} + \frac{\sigma_{20} e \tau_2 / m_2^*}{1 + \omega_c^2 \tau_2^2} \right) \mathbf{B} \times \boldsymbol{\varepsilon}$$

$$J_y = \left(\frac{\sigma_{10} \omega_{c1} \tau_1}{1 + \omega_{c1}^2 \tau_1^2} + \frac{\sigma_{20} \omega_{c2} \tau_2}{1 + \omega_{c2}^2 \tau_2^2} \right) E_x + \left(\frac{\sigma_{10}}{1 + \omega_{c1}^2 \tau_1^2} + \frac{\sigma_{20}}{1 + \omega_{c2}^2 \tau_2^2} \right) E_y$$

- 横向电流为零，可得 E_y ，低场下 $\omega_{ci}\tau_i \ll 1, i=1,2$

- 按定义

$$R_H = \frac{E_y}{BJ_x} = \frac{\sigma_{10}^2 R_{H1} + \sigma_{20}^2 R_{H2}}{(\sigma_{10} + \sigma_{20})^2}$$

- 令

$$A_i = \frac{\sigma_{i0}}{1 + \omega_{ci}^2 \tau_i^2}, C_i = \frac{\sigma_{i0} \omega_{ci} \tau_i}{1 + \omega_{ci}^2 \tau_i^2}, i=1,2$$

- 得


$$\rho = \frac{E_x}{J_x} = \frac{A_1 + A_2}{(A_1 + A_2)^2 + (C_1 + C_2)^2}$$

- 利用 $\omega_{ci} = eB/m_i^*$ ，令 $\mu_i = e\tau_i/m_i^*$

$$\rho_0 = \frac{1}{\sigma_{10} + \sigma_{20}}$$

- 经运算可得磁阻为

$$\frac{\Delta\rho}{\rho_0} = \frac{\rho - \rho_0}{\rho_0} = \frac{\sigma_{10}\sigma_{20}(\mu_1 - \mu_2)^2 B^2}{(\sigma_{10} + \sigma_{20})^2 + (\mu_1\sigma_{10} + \mu_2\sigma_{20})^2 B^2}$$



思考题：电场和磁场，哪种对分布函数的改变影响大？

→视野拓展→超导电现象

- 晶格振动(声子)对电子的散射是电阻的根源!
- 但是, 电子与声子作用, 在一定条件下能形成所谓的Cooper对→超导态
 - * Cooper电子对受声子散射不会改变总动量→无电阻
 - * 如果Cooper被拆散, 超导态将变成正常态→有电阻

本讲要点

$$\chi = \frac{1}{T} \left(\mathcal{L}_2 - \frac{\mathcal{L}_1^2}{\mathcal{L}_0} \right) \approx \frac{1}{3} \left(\frac{\pi k_B}{e} \right)^2 \sigma T$$

- 热导率

- * 热流伴随着电流和热电效应

- * 金属中热导主要是电子的贡献，晶格振动是次要的

- 热电势

- * 在电子导热过程中，电子—声子散射作用要复杂得多，不但要维持温度梯度，还要建立电场使电流为零

- 磁阻

- * 两种载流子，不同有效质量

$$\frac{\Delta\rho}{\rho_0} = \frac{\rho - \rho_0}{\rho_0} = \frac{\sigma_{10}\sigma_{20}(\mu_1 - \mu_2)^2 B^2}{(\sigma_{10} + \sigma_{20})^2 + (\mu_1\sigma_{10} + \mu_2\sigma_{20})^2 B^2}$$

新引入概念

- 输运系数
- 温差电动势
- Seebeck效应
- 磁阻

思考题

1. 为什么在开路情况下，传导电子能传输热流？为什么？
2. 能不能用自由电子气体模型定性说明热电现象？为什么？
3. 电场和磁场，哪种场对分布函数的改变影响大？为什么？

习题

30. (书中6.4题)如有浓度和电荷分别为 n_1e_1 和 n_2e_2 两种载流子存在时, 给出低场时霍尔系数的表示式。当 $n_1e_1+n_2e_2=0$, 即两种载流子相补偿时, 情况又如何?



课堂讨论题：剩余电阻与温度无关的原因是什么？